

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開2002 - 221736

(P2002 - 221736A)

(43)公開日 平成14年8月9日(2002.8.9)

(51) Int.CI ⁷	識別記号	F I	テ-マコード [®] (参考)
G 0 2 F 1/1368		G 0 2 F 1/1368	2 H 0 9 0
1/1333	505	1/1333	505
1/1343		1/1343	2 H 0 9 2

審査請求 未請求 請求項の数 100 L (全 10数)

(21)出願番号 特願2001 - 19809(P2001 - 19809)

(22)出願日 平成13年1月29日(2001.1.29)

(71)出願人 000005108
株式会社日立製作所
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
(72)発明者 倉橋 永年
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
製作所ディスプレイグループ内
(72)発明者 仲吉 良彰
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
製作所ディスプレイグループ内
(74)代理人 100083552
弁理士 秋田 収喜

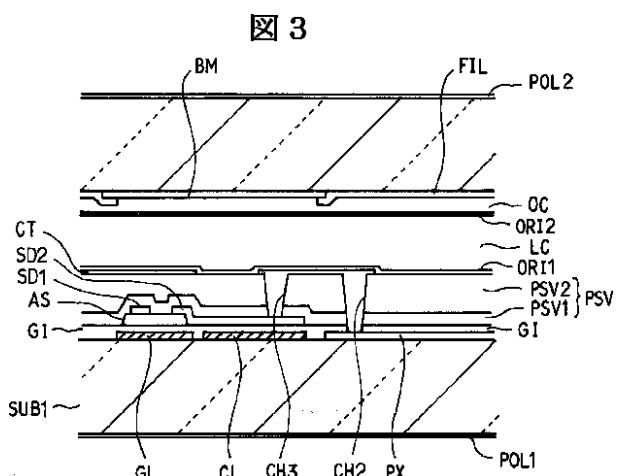
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 残像を抑制する。

【解決手段】 液晶を介して対向配置される基板のうち一方の基板の該液晶側の画素領域に、ゲート信号線からの走査信号の供給により駆動される薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタを介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界を生じせしめる対向電極とが備えられ、前記対向電極は積層絶縁膜を介して画素電極の上層に形成され、前記積層絶縁膜は、前記薄膜トランジスタのゲート絶縁膜を一部とする絶縁膜、無機材料層と有機材料層の順次積層体からなる保護膜からなり、前記対向電極は一方向に延在し該一方向に交差する方向に並設される複数の帯状電極からなるとともに、前記画素電極は画素領域の大部分の領域に形成される透光性の平面状電極からなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶を介して対向配置される基板のうち一方の基板の該液晶側の画素領域に、ゲート信号線からの走査信号の供給により駆動される薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタを介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界を生じせしめる対向電極とが備えられ、前記対向電極は積層絶縁膜を介して画素電極の上層に形成され。

前記積層絶縁膜は、前記薄膜トランジスタのゲート絶縁膜を一部とする絶縁膜、無機材料層と有機材料層の順次積層体からなる保護膜からなり、前記対向電極は一方向に延在し該一方向に交差する方向に並設される複数の帯状電極からなるとともに、前記画素電極は画素領域の大部分の領域に形成される透光性の平面状電極からなることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 画素電極と層を同じにして対向電圧信号線が形成され、この対向電圧信号線は前記積層絶縁膜に形成されたスルホールを通して対向電極に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 画素電極はこの上層に形成される積層絶縁膜に形成されたスルホールと薄膜トランジスタのソース電極の上層に形成される保護膜に形成されたスルホールとをして該ソース電極に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項4】 複数の各対向電極はドイレン信号線とほぼ平行に形成されているとともに、該ドレイン信号線に重畳され、かつ該ドレイン信号線と中心軸がほぼ一致づけられて該ドレイン信号線よりも幅広の対向電極を備えることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項5】 液晶を介して対向配置される基板のうち一方の基板の該液晶側の画素領域に、ゲート信号線からの走査信号の供給により駆動される薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタを介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界を生じせしめる対向電極とが備えられ、前記対向電極は保護膜を介して画素電極の上層に形成され、前記保護膜は、無機材料層と有機材料層の順次積層体からなり、

前記対向電極は一方向に延在し該一方向に交差する方向に並設される複数の帯状電極からなるとともに、前記画素電極は画素領域の大部分の領域に形成される透光性の平面状電極からなることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項6】 画素電極は薄膜トランジスタのゲート絶縁膜を一部とする絶縁膜上に形成されているとともに、この絶縁膜の下層に対向電圧信号線が形成され、この対向電圧信号線は前記保護膜および絶縁膜を貫通するスルホールを通して対向電極に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

* 【請求項7】 複数の各対向電極はドイレン信号線とほぼ平行に形成されているとともに、該ドレイン信号線に重畳され、かつ該ドレイン信号線と中心軸がほぼ一致づけられて該ドレイン信号線よりも幅広の対向電極を備えることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項8】 液晶を介して対向配置される基板のうち一方の基板の該液晶側の画素領域に、ゲート信号線からの走査信号の供給により駆動される薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタを介してドレイン信号線からの映像信号線が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界を生じせしめる対向電極とが備えられ、前記画素電極は、前記薄膜トランジスタを被って形成される無機材料層からなる第1保護膜上に画素領域の大部分に及んで平面状に形成されているとともに、該第1保護膜に形成されたコンタクトホールを通して該薄膜トランジスタのソース電極に接続された透光性の導電材からなり、

前記対向電極は、前記第1保護膜上に前記画素電極をも被って形成された有機材料層からなる第2の保護膜上に形成されているとともに、一方向に延在され該方向に交差する方向に並設された複数の電極群とからなることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項9】 対向電極は、透光性の導電材からなることを特徴とする請求項8に記載の液晶表示装置。

【請求項10】 ドレイン信号線とその中心線をほぼ同じにして重畳して配置される対向電極が存在し、その対向電極の幅は該ドレイン信号線の幅よりも大きく形成されていることを特徴とする請求項8に記載の液晶表示装置。

30 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係り、いわゆる横電界方式と称される液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】横電界方式と称される液晶表示装置は、液晶を介して対向配置される基板のうち一方の基板の液晶側の各画素領域に画素電極と対向電極とが形成され、これら各電極の間に発生する電界のうち基板にほぼ平行な方向の成分によって、液晶の光透過率を制御するようになっている。そして、このような液晶表示装置のうち、画素電極と対向電極とを絶縁膜を介して異なる層に形成し、一方の電極を画素領域のほぼ全域に形成された透明電極として形成するとともに、他方の電極を該画素領域のほぼ全域にわたって一方向に延在し該方向に並設する方向に並設された複数のストライブ状の透明電極として形成したものが知られるに到っている。このような技術としては、たとえば、K.Tarumi, M.Bremer, and B.Schuler, IEICE TRANS.ELECTRON., VOL. E79-C NO.8, p 40 p. 1035-1039, AUGUST 1996 に詳述されている。なお、

このような液晶表示装置にはいわゆるアクティブ・マトリクス方式が適用され、たとえばx方向に延在されy方向に並設されるゲート信号線とy方向に延在されx方向に並設されるゲート信号線とで囲まれる各画素領域に、一方のゲート信号線からの走査信号の供給によって駆動されるスイッチング素子が備えられ、このスイッチング素子を介して一方のドレイン信号線からの映像信号が前記画素電極に供給されるようになっている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このように構成された液晶表示装置は、画素電極と対向電極との間に生じる電界のうち、基板にほぼ垂直方向に生じる電界による残像が生じ易いことが指摘されているとともに、さらなる開口率の向上も要望されていた。本発明は、このような事情に基づくもので、その目的は、残像の生じ難い液晶表示装置を提供することにある。また、他の目的は開口率を向上させた液晶表示装置を提供することにある。

【0004】

【課題を解決するための手段】本発明において開示され20発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0005】すなわち、本発明による液晶表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される基板のうち一方の基板の該液晶側の画素領域に、ゲート信号線からの走査信号の供給により駆動される薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタを介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界を生じせしめる対向電極とが備えられ、前記対向電極は積層絶縁膜を介して画素電極の上層に形成され、前記積層絶縁膜は、前記薄膜トランジスタのゲート絶縁膜を一部とする絶縁膜、無機材料層と有機材料層の順次積層体からなる保護膜からなり、前記対向電極は一方向に延在し該一方向に交差する方向に並設される複数の帯状電極からなるとともに、前記画素電極は画素領域の大部分の領域に形成される透光性の平面状電極からなることを特徴とするものである。

【0006】このように構成した液晶表示装置は、画素電極と対向電極との間に介在される絶縁膜は無機材料層と有機材料層の順次積層体から構成され、その誘電率を小さくすることができ、また厚膜化が容易であることから、基板にほぼ垂直方向に生じる電界による残像が生じ難くなる。

【0007】また、本発明による液晶表示装置は、上記の構成において、複数の各対向電極はドレン信号線とほぼ平行に形成されるとともに、該ドレン信号線に重畳され、かつ該ドレン信号線と中心軸がほぼ一致づけられて該ドレン信号線よりも幅広の対向電極を備えることを特徴とするものである。

【0008】

このように構成した液晶表示装置では、ゲート信号線の形成領域においてもそれに重畳させて対向電極が形成されていることから、開口率を向上させることができるようになる。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置の実施例を図面を用いて説明をする。

【0010】実施例1.

《等価回路》図2は本発明による液晶表示装置の等価回路を示す図である。同図は等価回路であるが、実際の幾何学配置に対応した図となっている。同図において、透明基板SUB1があり、この透明基板SUB1は液晶を介して他の透明基板SUB2と対向して配置されている。

【0011】前記透明基板SUB1の液晶側の面には、図中x方向に延在しy方向に並設されるゲート信号線GLと、このゲート信号線GLと絶縁されてy方向に延在しx方向に並設されるドレン信号線DLとが形成され、これら各信号線で囲まれる矩形状の領域が画素領域となり、これら各画素領域の集合によって表示部ARを構成するようになっている。

【0012】また、各ゲート信号線GLの間には該ゲート信号線GLと平行に配置された対向電圧信号線CLが形成されている。これら各対向電圧信号線CLは後述する映像信号に対して基準となる信号(電圧)が供給されるようになっており、各画素領域において後述する対向電極CTと接続されるようになっている。

【0013】各画素領域には、一方のゲート信号線GLからの走査信号(電圧)の供給によって駆動される薄膜トランジスタTFTと、この薄膜トランジスタTFTを介して一方のドレン信号線DLからの映像信号(電圧)が供給される画素電極PIXが形成されている。

【0014】また、画素電極PIXと対向電圧信号線CLとの間には容量素子Cstgが形成され、この容量素子Cstgによって、前記薄膜トランジスタTFTがオフした際に、画素電極PIXに供給された映像信号を長く蓄積させるようになっている。

【0015】各画素領域における画素電極PIXは、この画素電極PIXと隣接する対向電極CTとの間に透明基板SUB1に対してほぼ平行な成分を有する電界を発生せしめるようになっており、これにより対応する画素領域の液晶の光透過率を制御するようになっている。

【0016】各ゲート信号線GLの一端は透明基板の一边側(図中左側)に延在され、その延在部は該透明基板SUB1に搭載される垂直走査回路からなる半導体集積回路GDRのバンプと接続される端子部GTMが形成され、また、各ドレン信号線DLの一端も透明基板SUB1の一端側(図中上側)に延在され、その延在部は該透明基板SUB1に搭載される映像信号駆動回路からなる半導体集積回路DDRCのバンプと接続される端子部DTMが形成されている。

【0017】半導体集積回路G D R C、D D R Cはそれぞれ、それ自体が透明基板S U B 1上に完全に搭載されたもので、いわゆるCOG(チップオングラス)方式と称されている。

【0018】半導体集積回路G D R C、D D R Cの入力側の各バンプも透明基板S U B 1に形成された端子部G T M 2、D T M 2にそれぞれ接続されるようになっており、これら各端子部G T M 2、D T M 2は各配線層を介して透明基板S U B 1の周辺のうち最も端面に近い部分にそれぞれ配置された端子部G T M 3、D T M 3に接続されるようになっている。また、各対向電圧信号線C Lの一端(右端)は、それぞれ共通に接続されて透明基板S U B 1の端辺にまで延在されて端子部C T Mに接続されている。

【0019】前記透明基板S U B 2は、前記半導体集積回路が搭載される領域を回避するようにして透明基板S U B 1と対向配置され、該透明基板S U B 1よりも小さな面積となっている。

【0020】そして、透明基板S U B 1に対する透明基板S U B 2の固定は、該透明基板S U B 2の周辺に形成されたシール材S Lによってなされ、このシール材S Lは透明基板S U B 1、S U B 2の間の液晶を封止する機能も兼ねている。

【0021】なお、上述した説明では、COG方式を用いた液晶表示装置について説明したものであるが、本発明はTCP方式のものであっても適用できる。ここで、TCP方式とは、半導体集積回路がテープキャリア方式によって形成されたもので、その出力端子が透明基板S U B 1に形成された端子部に接続され、入力端子が該透明基板S U B 1に近接して配置されるプリント基板上の端子部に接続されるようになっている。

【0022】《画素の構成》図1は上述した液晶表示装置の画素の一実施例を示す平面図である。また、同図のIII-III線における断面図を図3に、IV-IV線における断面図を図4に、V-V線における断面図を図5に示している。

【0023】なお、この実施例の液晶表示装置は、その画素電極P Xと対向電極C Tとの間に透明基板S U B 1とほぼ平行な成分をもつ電界が発生していない場合には黒表示がなされるノーマリブラックモードの構成となっており、このノーマリブラックモードは液晶の特性(この実施例ではたとえばp型)、画素電極P Xと対向電極C Tとの間の電界の方向、配向膜O R Iのラビング方向、偏光板P O Lの偏光透過軸方向によって設定できるようになっている。

【0024】まず、透明基板S U B 1の表面であって画素領域の下側には図中x方向に延在するゲート信号線G Lが形成されている。このゲート信号線G LはたとえばCrあるいはその合金からなっている。

【0025】このゲート信号線G Lは、該画素領域の上

側に位置づけられる画素領域の対応するゲート信号線(図示せず)、後述するドレイン信号線D L、該画素領域の右側に位置づけられる画素領域の対応するドレイン信号線(図示せず)とともに、該画素領域を囲むようにして形成されている。

【0026】また、前記ゲート信号線G Lに隣接して該ゲート信号線G Lと平行に走行する対向電圧信号線C Lが形成されている。この対向電圧信号線C Lはたとえばゲート信号線G Lの形成の際に同時に形成され、たとえばCrあるいはその合金からなっている。

【0027】また、透明基板S U B 1の上面には、前記ゲート信号線G Lと対向電圧信号線C Lとの形成領域を回避してたとえばITO(Indium-Tin-Oxide)膜あるいはIZO(Indium-Zinc-Oxide)膜等からなる透光性の画素電極P Xが形成されている。この画素電極P Xは画素領域の大部分に形成された平面状の電極として形成されている。

【0028】このようにゲート信号線G L、対向電圧信号線C L、画素電極P Xが形成された透明基板S U B 1の表面にはこれらゲート信号線G L等をも被ってたとえばSiN等からなる絶縁膜G Iが形成されている(図3、図4、図5参照)。

【0029】この絶縁膜G Iは、前記ゲート信号線G L、対向電圧信号線C Lに対しては後述のドレイン信号線D Lとの層間絶縁膜としての機能を、後述の薄膜トランジスタT F Tに対してはそのゲート絶縁膜としての機能を、後述の容量素子C s t gに対してはその誘電体膜としての機能を有するようになっている。

【0030】そして、前記絶縁膜G Iの上面であってゲート信号線G Lと重畠する部分にたとえばアモルファスSi(a-Si)からなる半導体層A Sが形成されている。この半導体層A Sは薄膜トランジスタT F Tの半導体層となり、この上面にドレイン電極S D 1およびソース電極S D 2を形成することによって、ゲート信号線G Lの一部をゲート電極とする逆スタガ構造のM I S型トランジスタが形成されるようになっている。

【0031】なお、この半導体層A Sは薄膜トランジスタT F Tの形成領域ばかりでなく、後述のドレイン信号線D Lの形成領域にも形成されている。該ドレイン信号線D Lのゲート信号線G Lおよび対向電圧信号線C Lに対する層間絶縁膜としての機能を前記絶縁膜G Iとともにもたせるためである。

【0032】薄膜トランジスタT F Tのドレイン電極S D 1はドレイン信号線D Lと同時に形成されるようになっており、この際に、該ドレイン電極S D 1と薄膜トランジスタT F Tのチャネル長に相当する分だけの間隔を有してソース電極S D 2が形成されるようになっている。

【0033】すなわち、前記絶縁膜G I上にて図中y方向に延在するドレイン信号線D Lが形成され、この際

に、その一部が前記半導体層ASの上面まで延在させることによってドイン電極SD1が形成されている。これらドレイン信号線DLおよびドレイン電極SD1はたとえばCrあるいはその合金によって形成されている。

【0034】また、この際に形成されるソース電極SD2は半導体層ASの形成領域をはみ出して延在され、この延在部は前記画素電極PXとの接続を図るコンタクト部となっている。また、ソース電極SD2は対向電圧信号線CLとの間の容量素子Cstgとしての機能を有するようになっている。

【0035】このように薄膜トランジスタTFT、ドレイン信号線DL、画素電極PXが形成された透明基板SUB1の表面には該薄膜トランジスタTFT等をも被つてたとえばSiN等からなる無機膜PSV1および樹脂膜等からなる有機膜PSV2の順次積層体からなる保護膜PSVが形成されている(図3、図4、図5参照)。この保護膜PSVは主として薄膜トランジスタTFTの液晶LCとの直接の接触を回避させるために形成されている。

【0036】保護膜PSVの一部として樹脂膜等からなる有機膜PSV2を用いているのは、該有機膜PSV2の誘電率が小さいことから、該保護膜PSVの下層に位置づけられる信号線と該保護膜PSVの上層に位置づけられる電極との間に生じる容量を小さくさせるためである。

【0037】これにより、前記画素電極PXと後述の対向電極CTとの間に発生する電界のうち透明基板SUB1とほぼ垂直方向の電界は、誘電率の小さな前記保護膜によって残像を発生し難くなる。

【0038】有機膜PSV2は、該無機膜PSV1と比較して厚膜化が容易であり、無機膜PSV1と比較して平坦な表面を得ることが容易である。そのため、透明基板SUB1上の配線等の端部の段差が原因で生じる配向膜の塗布不良や、ラビング時の陰による初期配向不良、液晶のスイッチング異常(ドメイン)を防止する効果がある。

【0039】そして、この保護膜PSVの上面には図中y方向に延在し×方向に並設される複数の帯状の対向電極CTが形成されている。この対向電極CTはたとえばITO(Indium-Tin-Oxide)膜あるいはIZO(Indium-Zinc-Oxide)膜等のような透明の導電膜から形成されている。

【0040】これら各対向電極CTは、前記対向電圧信号線CLと重畳する領域にて互いに接続されるパターンとすることにより電気的に接続された構成となっているとともに、ここの部分にて前記保護膜PSV(有機膜PSV2、無機膜PSV1)に形成されたコンタクトホールCH1を介して前記対向電圧信号線CLに接続されている。

【0041】また、このコンタクトホールCH1の形成

の際に、画素電極PXの一部を露出させるコンタクトホールCH2および薄膜トランジスタTFTのソース電極SD2の延在部の一部を露出させるコンタクトホールCH3も形成され、前記対向電極CTを構成する材料によって、画素電極PXと薄膜トランジスタTFTのソース電極SD2とが接続されている。

【0042】さらに、前記ドレイン信号線DLの形成領域上において該ドレイン信号線DLの中心軸をほぼ同じにし、かつ該ドレイン信号線DLよりも幅広の対向電極CTが形成されている。換言すれば、この対向電極CTを透明基板SUB1を垂直方向から観た場合に前記ドレイン信号線DLが露出することなく完全に被った状態で形成されている。

【0043】この対向電極CTは、たとえばITO膜等からなる透明の導電層で形成されているにも拘らず、ドレイン信号線DLの近傍において液晶を駆動させる電界による光漏れを遮光する遮光膜として機能するようになっている。

【0044】すなわち、上述したように、この液晶表示装置は画素電極PXと対向電極CTとの間に透明基板SUB1とほぼ平行な成分をもつ電界が発生していない際には黒表示がなされるノーマリブラックモードの構成となっている。このことは対向電極CTの上方において、透明基板SUB1とほぼ垂直方向に電界が多く発生しており、該透明基板SUB1とほぼ平行な成分をもつ電界が発生していないことから黒表示されることになり、前記対向電極CTは遮光膜の代わりとすることができる。

【0045】また、ドレイン信号線DL上の対向電極CTは、該ドレイン信号線DLから生じる電界を終端させることができ、該ドレイン信号線DLと隣接する画素電極PX側に終端するのを抑制できるようになっている。

【0046】この場合、保護膜PSVは積層体として構成し、その上層に誘電率の低い樹脂層からなる保護膜PSV2を用いていることもドレイン信号線DLからの電界を容易に該対向電極CT側に終端させやすくしている。

【0047】このことは、画素電極PXは薄膜トランジスタTFTを介した映像信号に基づく電界のみを対向電極CTとの間に発生せしめることができ、ドレイン信号線DLからのノイズとなる電界が侵入しないことから表示の不良を回避できる構成となっている。

【0048】さらに、対向電極CTはドレイン信号線DLの形成領域にまで及んで形成された構成となっているため、たとえば設定された本数の対向電極CTの離間距離が大きくなり、これにより開口率の向上が図れるようになる。

【0049】このように対向電極CTが形成された透明基板SUB1の表面には該対向電極CTをも被って配向膜ORI1が形成されている。この配向膜ORI1は液晶LCと直接に接触して該液晶LCの分子の初期配向方

向を規制する膜で、この実施例では、そのラビング方向は図中y方向に対して+ 方向あるいは- 方向となっている。ここで、前記 は0°より大きく45°より小さく、望ましくは5°から30°の範囲に設定されている。

【0050】なお、透明基板SUB1の液晶側と反対側の面には偏光板POL1が形成され、その偏光軸方向は前記配向膜ORI1のラビング方向と同一あるいはそれと直交する方向となっている。

【0051】また、このように構成された透明基板SUB1と液晶LCを介して対向配置される透明基板SUB2の液晶側の面には、各画素領域を画するようにしてブラックマトリクスBMが形成されている。このブラックマトリクスBMは表示のコントラストを向上させるため、そして、薄膜トランジスタTFTへの外来光の照射を回避するために形成されている。

【0052】このようにブラックマトリクスBMが形成された透明基板SUB2の表面には、y方向に並設される各画素領域に共通な色のカラーフィルタFLが形成され、x方向にたとえば赤(R)、緑(G)、青(B)の順に配置されている。

【0053】そして、これらブラックマトリクスBMおよびカラーフィルタFLをも被ってたとえば樹脂膜からなる平坦化膜OCが形成され、この平坦化膜OCの表面には配向膜ORI2が形成されている。この配向膜ORI2のラビング方向は透明基板SUB1側の配向膜のそれと同じになっている。

【0054】なお、透明基板SUB1の液晶側と反対側の面には偏光板POL2が形成され、その偏光軸方向は前記透明基板SUB1側に形成した偏光板POL1の偏光軸方向と直交する方向となっている。

【0055】本実施例に示した有機膜PSV2の他の機能として、保護膜自体の信頼性を向上する効果もある。従来の無機膜PSV1単体で保護膜を構成した場合、配線端部のカバレジ不良によって生じた微細な欠陥から、配線材料の一部が液晶内部に流出し、液晶の電気-光学特性に影響を与える場合があった。良好なカバレジが得られ、厚膜が得られる有機膜PSV2を導入することで上記の不良を防止できる。

【0056】上述した実施例では、ノーマリブラックモードの構成の液晶表示装置について説明したものである。しかし、ノーマリホワイトモードの構成についても適用できることはいうまでもない。

【0057】実施例2. 図6は本発明による液晶表示装置の画素構成の他の実施例を示す平面図であり、図1に対応した図面となっている。また、同図のVII-VII線における断面図を図7に、VIII-VIII線における断面図を図8に示している。実施例1の場合と異なる構成は、画素電極PXは絶縁膜GIの上層に、また保護膜PSVの下層に形成されていることがある。このため、この画素*50

*電極PXは薄膜トランジスタTFTのソース電極SD2と同層に形成され、これらの接続にあってコンタクトホールを必要としなくなる。すなわち、該ソース電極SD2の延在部を設け、この延在部に画素電極PXが重ねられるようにして形成することにより、それらの接続がなされる。保護膜PSVは、実施例1と同様に、無機材料層からなる保護膜PSV1および有機材料層からなる保護膜PSV2の順次積層体から構成されているため、その誘電率を小さくでき、信号線と該保護膜PSV上に形成される対向電極CTとの容量結合を小さくすることができる。

【0058】実施例3. 図9は本発明による液晶表示装置の画素構成の他の実施例を示す平面図であり、図6に対応した図面となっている。また、同図のX-X線における断面図を図10に、XI-XI線における断面図を図11に示している。実施例1、2の場合と異なる構成は、画素電極PXは無機材料層からなる保護膜PSV1の上層、有機材料層からなる保護膜PSV2の下層に形成されていることにある。該画素電極PXは、無機材料層からなる保護膜PSV1を介して薄膜トランジスタTFTのソース電極SD2と異なる層に形成されることから、該保護膜PSV1に形成されたコンタクトホールCH4を介して該ソース電極SD2とが接続されるようになっている。これにより、画素電極PXと対向電極CTとの間には、有機材料層からなる保護膜PSV2のみが介在される構成となる。また、この保護膜PSV2は有機材料を塗布することによって形成できることから、その膜厚を容易に大きくでき、たとえば無機材料層の層厚よりも大きく構成することにより、信号線と対向電極CTの容量結合を極力小さくすることができるようになる。

【0059】

【発明の効果】以上説明したことから、本発明による液晶表示装置によれば、残像の発生を抑止することができる。また、開口率の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による液晶表示装置の画素構成の一実施例を示す平面図である。

【図2】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す等価回路図である。

【図3】図1のIII-III線における断面図である。

【図4】図1のIV-IV線における断面図である。

【図5】図1のV-V線における断面図である。

【図6】本発明による液晶表示装置の画素構成の他の実施例を示す平面図である。

【図7】図6のVII-VII線における断面図である。

【図8】図6のVIII-VIII線における断面図である。

【図9】本発明による液晶表示装置の画素構成の他の実施例を示す平面図である。

【図10】図9のX-X線における断面図である。

【図11】図9のXI-XI線における断面図である。

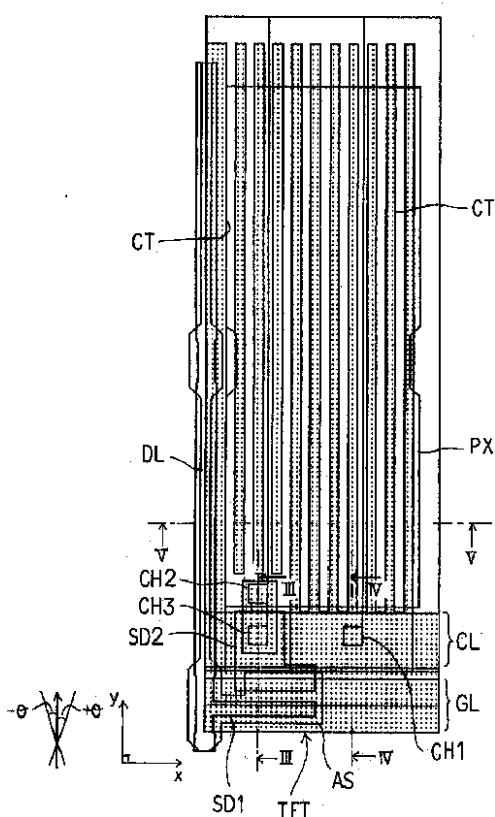
【符号の説明】

SUB1、SUB2...透明基板、GL...ゲート信号線、
 CL...対向電圧信号線、GI...絶縁膜、AS...半導体
 層、SD1...ドレイン電極、SD2...ソース電極、TF*

*T...薄膜トランジスタ、PSV1...無機材料層からなる
 保護膜、PSV2...有機材料層からなる保護膜、CT...
 対向電極。

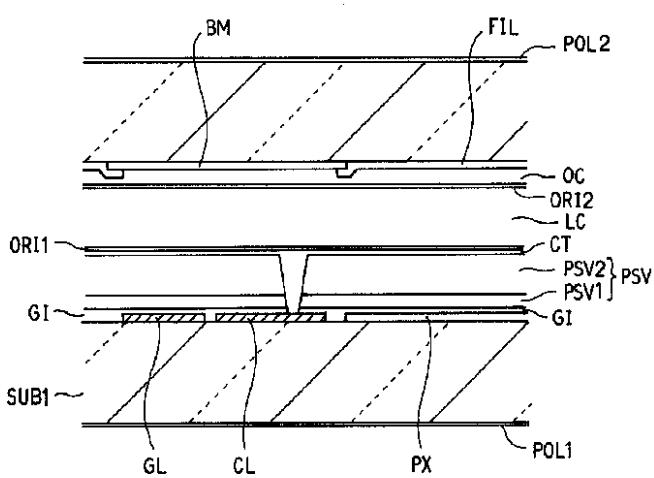
【図1】

図1



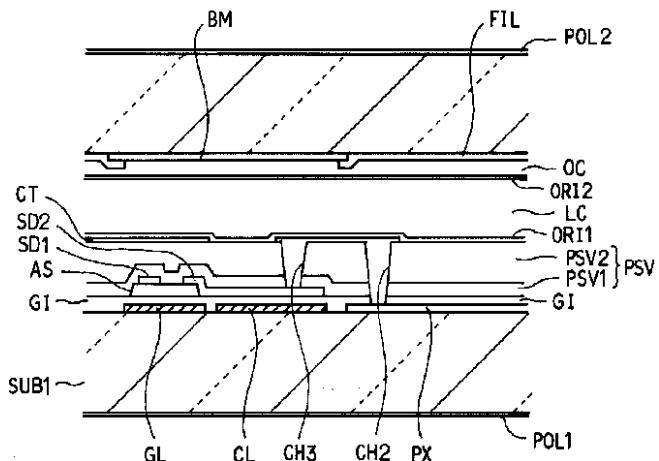
【図4】

図4



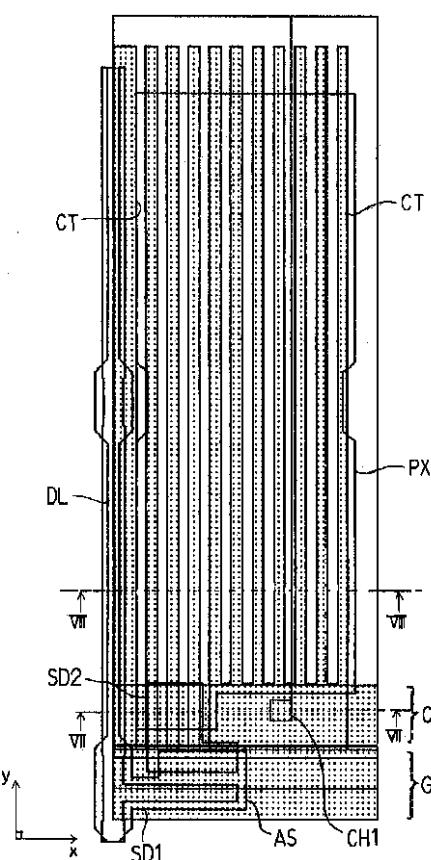
【図3】

図3



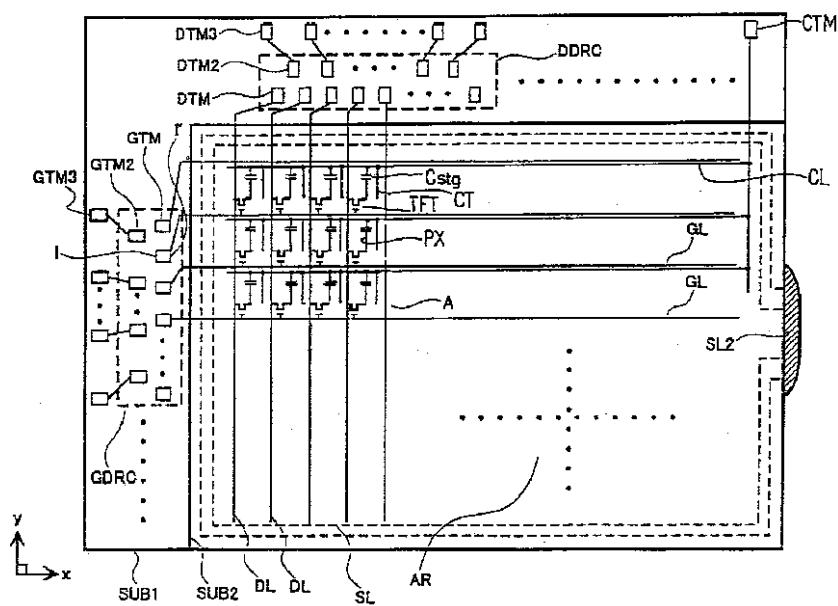
【図6】

図6



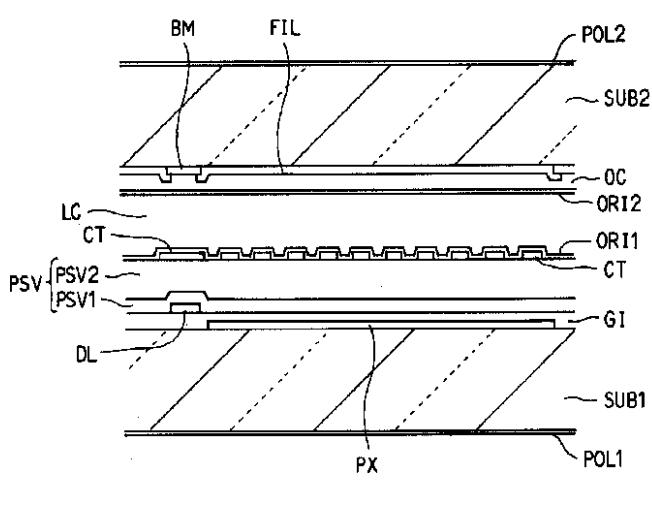
【図2】

図2



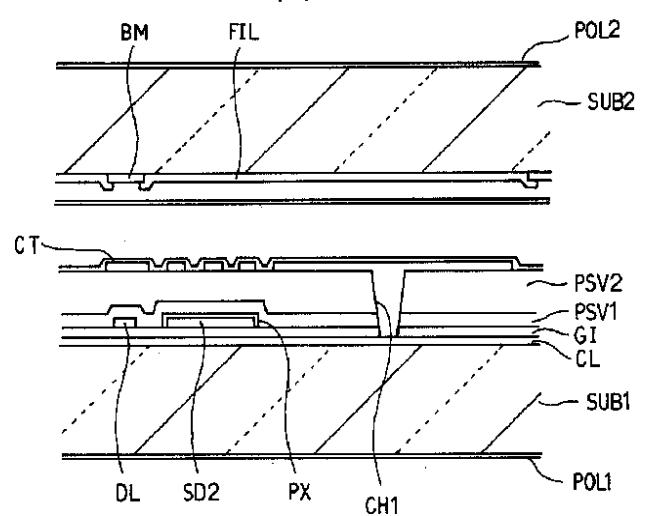
【図5】

図5



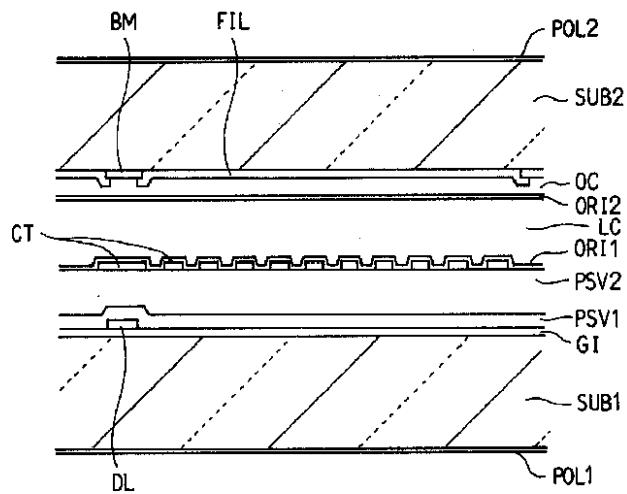
【図7】

図7



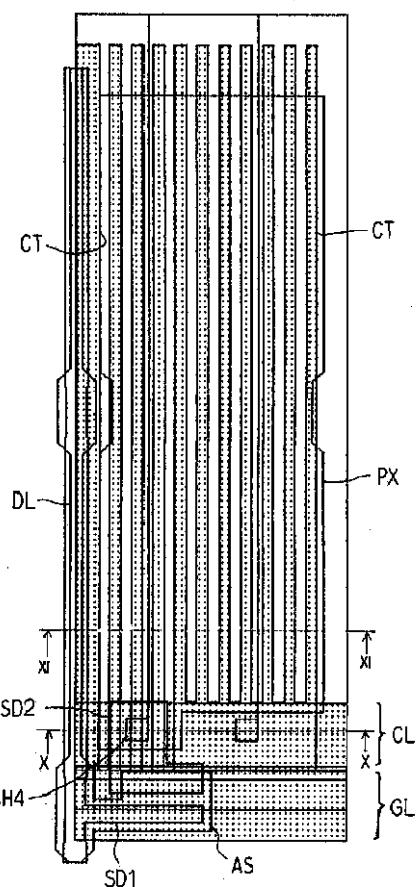
【図8】

図8



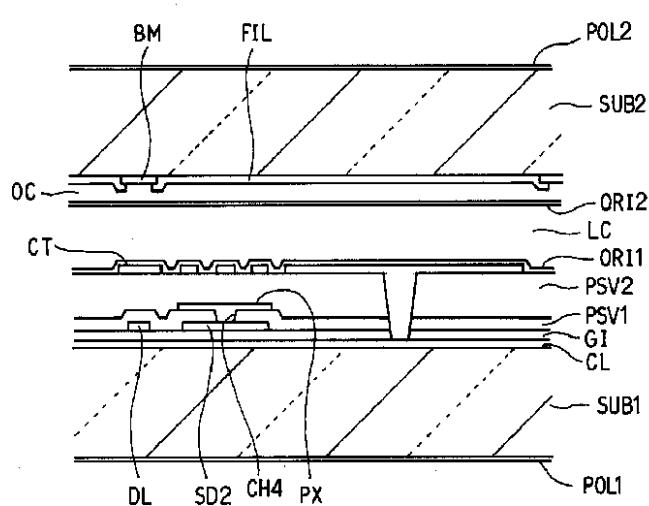
【図9】

図9



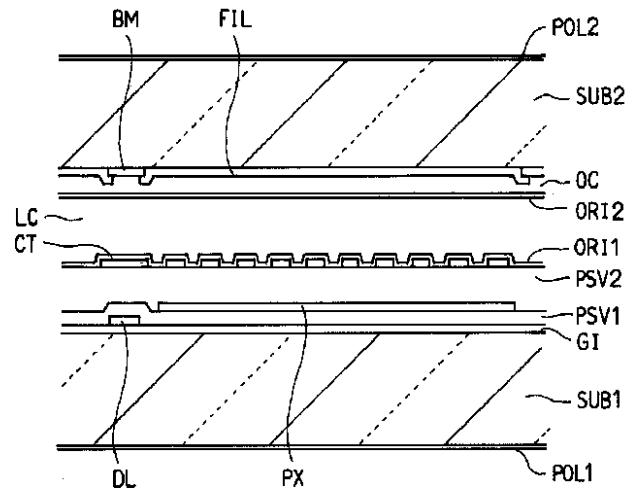
【図10】

図10



【図11】

図11



フロントページの続き

(72)発明者 石井 正宏
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
製作所ディスプレイグループ内

F ターム(参考) 2H090 HA02 HA06 HD01 KA04 LA01
2H092 GA14 GA17 JA26 JB52 JB56
NA07 NA25

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP2002221736A	公开(公告)日	2002-08-09
申请号	JP2001019809	申请日	2001-01-29
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
[标]发明人	倉橋永年 仲吉良彰 石井正宏		
发明人	倉橋 永年 仲吉 良彰 石井 正宏		
IPC分类号	G02F1/1333 G02F1/1343 G02F1/1368		
CPC分类号	G02F1/134363 G02F2201/121		
FI分类号	G02F1/1368 G02F1/1333.505 G02F1/1343		
F-TERM分类号	2H090/HA02 2H090/HA06 2H090/HD01 2H090/KA04 2H090/LA01 2H092/GA14 2H092/GA17 2H092/JA26 2H092/JB52 2H092/JB56 2H092/NA07 2H092/NA25 2H190/HA02 2H190/HA06 2H190/HD00 2H190/KA04 2H190/LA01 2H192/AA24 2H192/BB12 2H192/BB64 2H192/BB73 2H192/BC32 2H192/BC44 2H192/CB05 2H192/CB46 2H192/CC04 2H192/CC57 2H192/DA32 2H192/DA74 2H192/EA04 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/EA67 2H192/FB22 2H192/JA33		
其他公开文献	JP3949897B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

(带更正) 残像被抑制。在通过液晶彼此相对的基板之一的液晶侧像素区域中，通过经由栅极从栅极信号线和漏极信号提供扫描信号而驱动的薄膜晶体管。设置有从线路提供有视频信号的像素电极和用于在像素电极与像素电极之间产生电场的对电极，该对电极隔着层叠的绝缘膜形成在像素电极的上层，层叠绝缘膜由以薄膜晶体管的栅极绝缘膜为一部分的绝缘膜，和由无机材料层和有机材料层的依次层叠体形成的保护膜构成，对电极在一个方向和一个方向上延伸。像素电极由在彼此交叉的方向上平行布置的多个带状电极组成，并且像素电极由形成在大部分像素区域中的透光平面电极组成。

